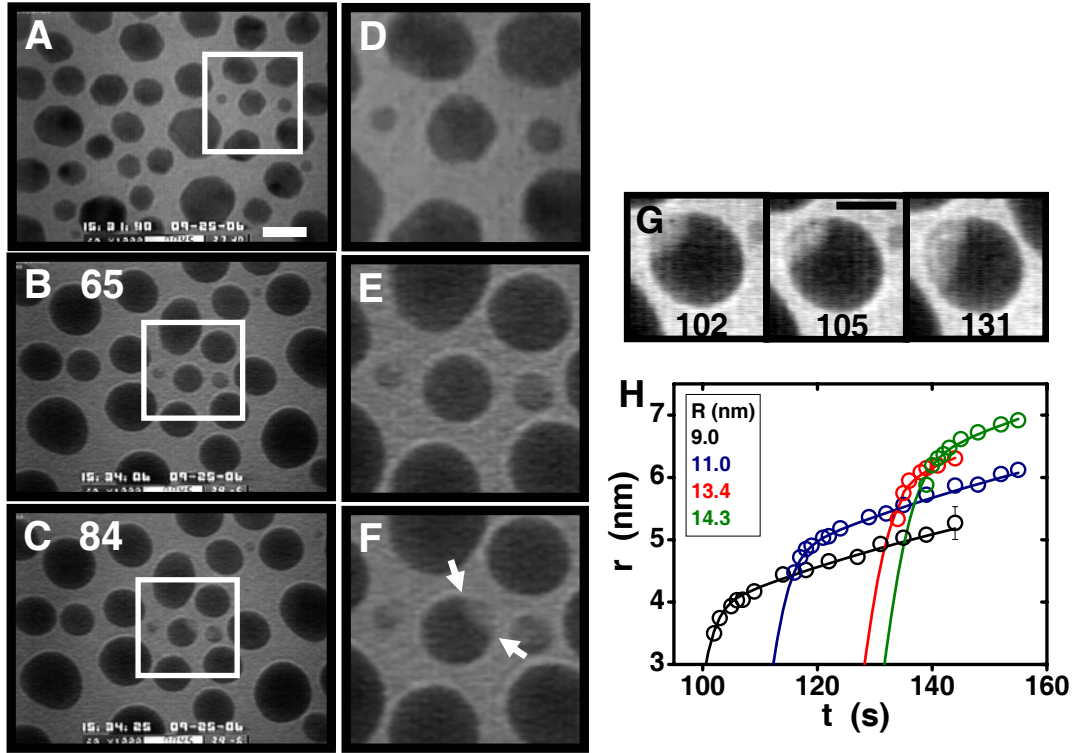


※ 연구사진설명



<사진설명: (A-C) 섭씨 525°C, 디실란(disilane) 압력 4×10^{-6} Torr 에서 금 입자로부터 생성된 실리콘의 핵 생성과정. 사진은 실시간 투과전자현미경으로부터 촬영된 영상에서 얻어짐. 크기막대: 20 나노미터(nm) (D-F) A - C의 사각형 영역을 확대한 사진. 화살표는 액상의 금-실리콘화합물(AuSi)과 고상의 실리콘(Si)의 상경계면을 표시하고 있다. (G) 같은 조건에서 성장중인 실리콘 핵의 사진. 크기막대: 10 나노미터(nm) (H) 같은 조건에서 여러 다른 크기의 금 입자로부터 나온 실리콘 핵의 성장도표. 사진내의 숫자는 디실란(disilane) gas 주입이후의 시간을 나타낸다. >